3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成23年12月12日から平成24年１月20日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成23年12月19日10時00分
⑵　開催場所　東北大学未来科学技術共同研究センター１階小会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 12
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Wafer Handling System 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　Wafer Bonding Unit
a　The wafer-bonding unit is required to have capabilities of, that transfer the topography silicon wafer and glass support separately, that spin-coat adhesive on either the silicon wafer or glass support, and that can bond the silicon wafer to glass support.
b　The wafer-bonding unit is required to consist of the transfer unit and the process unit. Moreover, the process unit is required to consist of separate units ; spin coating, bake, TTV measurement, pre-alignment, alignment and bonding unit.
c　The process wafer sizes at the wafer-bonding unit are both φ200㎜ and φ300㎜.
d　The adhesive, that has thermal stability for solder reflow process and has chemical stability against polar base solvent, is required to be used.
e　The spin coating unit is required to have pre-wet and edge rinse function.
f　Thickness of adhesive is required to cover from 5μm to 120μm.
g　The wafer-bonding unit is required to have more than 6 of bake unit.
h　The wafer-bonding unit is required to measure the adhesive thickness by non-contacting method (Also, required for mapping).
i　The wafer-bonding unit is required to have pre-alignment unit and alignment unit (XY : ±0.1㎜, θ : ±0.1 °) that are processed before bonding process.
j　Bonding unit is required to have the bonding capability within 50～250℃ temperature range and vacuum below 10Pa.
B　The Wafer debonding unit
a　The wafer debonding unit is required to have capabilities of, that transfer the thinned silicon wafer, mounted to tape frame and bonded to glass support, that debond the glass support and the debonding method has no mechanical, thermal force or low wavelength area of ultra violate lay, which is possible to impact the wafer device performance.
b　The wafer debonding unit is required to consist of the transfer unit and the debonding process unit.
c　The process wafer sizes at the wafer-bonding unit are both φ200㎜ and φ300㎜.
d　The debonding unit is required to include the collecting station of post-debonded glass support.
e　The wafer debonding-unit is required to have the transfer tact time as ＜300sec at 100μm adhesive thickness (＞12 wafer per hour).
f　The debonded thinned wafer need to be crack or chipping free.
g　The solvent, containing the ＜1ppm impurity level, is required to be used.
h　The wafer debonding unit is required to have a unit that can chemically clean the thinned wafer mounted to tape frame for the post-debonding step. Also, the chemical cleaning process is required to not damage (Dissolve, Swell) to the dicing tape of PVC.
i　No adhesive residue on the thinned wafer surface after chemical cleaning is required.
j　The wafer positioning is required as frame alignment and also wafers alignment.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 20, January, 2012
⑹　Contact point for the notice : Higuchi Hideki, Procurement Section, Finance Department, Tohoku University, 2―1―1 Katahira Aoba-ku Sendai-shi 980―8577 Japan, TEL 022―217―4869

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 23 年 12 月 12 日
国立大学法人東北大学理事　植木　俊哉
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　04

○第６号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　12
⑵　導入計画物品及び数量
ウェハ研磨装置　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成24年度５月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　φ300㎜ウェーハの対応　φ200㎜とφ300㎜ウェーハの兼用仕様であり、研削、化学的機械研磨（ＣＭＰ）、高い清浄度で洗浄、エッジトリミングを行うことが可能であること。
B　構成　粗研削軸（Ｚ１）、仕上げ研削軸（Ｚ２）、ＣＭＰ軸（Ｚ３）、ＣＭＰの仕上げ研磨軸（Ｚ４）の４軸構成であること
C　洗浄機能　以下薬液が使用可能なこと。
アルカリ薬液（ＳＣ－１）、酸薬液（クエン酸）、オゾン水
また、ウェーハ表面（加工面）はＰＶＡ製のブラシ洗浄が出来る機構を備えていること。
D　パーティクル対策　筐体にＵＬＰＡフィルタ内蔵のＦＦＵ（ファンフィルタユニット）が設置されていること。
E　ワーク搬送可能厚さ　最大1.5㎜以上の総厚のワークが搬送可能であること。
F　非接触厚さ測定機構　研削中のウェーハの厚さを非接触にて測定できること。
G　加工負荷制御　圧力センサを用いてＣＭＰ時の接触負荷を制御する加工方式を用いていること。（検知可能荷重範囲　０～2,000Ｎ程度）
H　チャックテーブル　水冷式の冷却機構を採用していること。
I　搬送アームのクランプ　バキューム方式ではなく、エッジクランプ方式であること。また、搬送中加工面を乾かさないよう純水によるウエット搬送が行えること。
J　エッジトリミング機構
a　貼り合わせ前後のウェーハのエッジトリミングが可能であること。
b　加工後にオゾン洗浄が可能なシステムであること。
c　ハーフカットダイシングも可能であること。
d　φ300㎜のウェーハからφ200㎜にリサイズ加工が可能なこと。
K　スラリーの対応　以下品種のスラリーに対応していること。
組成　アルカリ、有機アルカリ、砥粒シリカ
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成24年１月20日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒980―8577　仙台市青葉区片平２－１－１　東北大学財務部資産・調達管理課調達管理第二係長　樋口　秀樹　電話022―217―4869
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成23年12月12日から平成24年１月20日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。